

2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2
Бескорпусные высокочастотные биполярные р-п-р транзисторы малой мощности

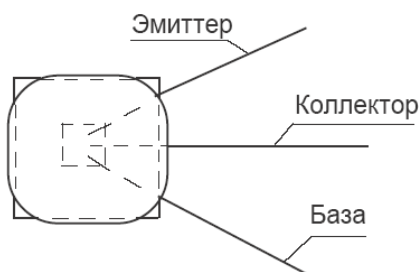
Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 1,2$ ГГц
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Kmax} = 120$ мВт
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Kэmax} = 35$ В

Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
2Т3150А-2 2Т3150Б-2 КТ3150Б-2	аА0.339.462 ТУ аА0.339.462 ТУ аА0.336.827 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4	-60°С до +85°С

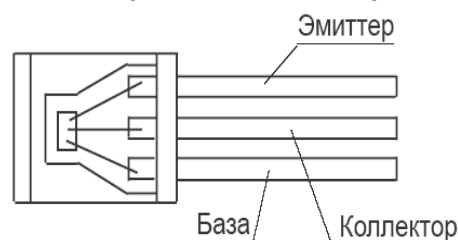
Бескорпусные на кристаллодержателе (подложке) с защитным покрытием и гибкими выводами кремниевые планарно-эпитаксиальные р-п-р усилительные транзисторы 2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям аА0.339.462 ТУ и аА0.336.827 ТУ. Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности.

Схема расположения выводов



Сопроводительная тара



ТС4

2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2

Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10) ^\circ C$

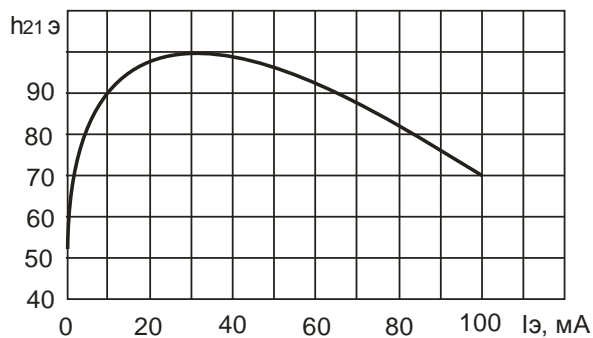
Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ}=40$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ}=4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=2,5$ мА, $t_{и} \leq 2$ мс)	$h_{21Э}$	60	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=10$ мА, $f=100$ МГц)	$ h_{21Э} $	12	
Время рассасывания ($I_К=10$ мА, $I_Б=1$ мА), нс	$t_{рас}$		30
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_К=10$ мА, $I_Б=1$ мА), В	$U_{БЭнас}$		1,2
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К=10$ мА, $I_Б=1$ мА), В	$U_{КЭнас}$		0,25
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ}=5$ В, $I_Э=10$ мА, $f=30$ МГц), пс	τ_K		30
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ}=10$ В, $f=10$ МГц), пФ	C_K		2
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ}=0$ В, $f=10$ МГц), пФ	$C_Э$		2



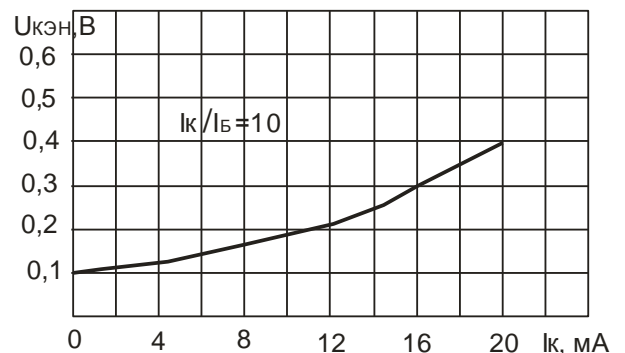
Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т3150А-2, 2Т3150Б-2, КТ3150Б-2	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\max}$	35	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	4	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	30	
Импульсный ток коллектора при $t_{\text{и}} \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 2$, мА	$I_{К\text{и}\max}$	50	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт при $T = \text{от } -60 \text{ до } +65^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$ При изменении температуры от $+65$ до $+85^\circ\text{C}$ $P_{К\max}$ уменьшается линейно	$P_{К\max}$	120 88	
Температура р-п перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{\text{п}}$	+125	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{Тп-с}}$	450	

Основные типовые зависимости параметров транзисторов



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.